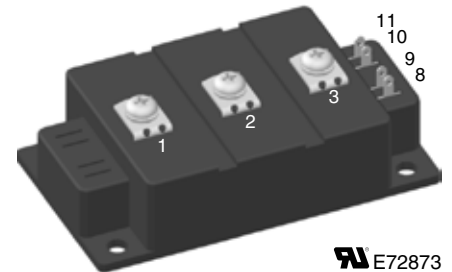
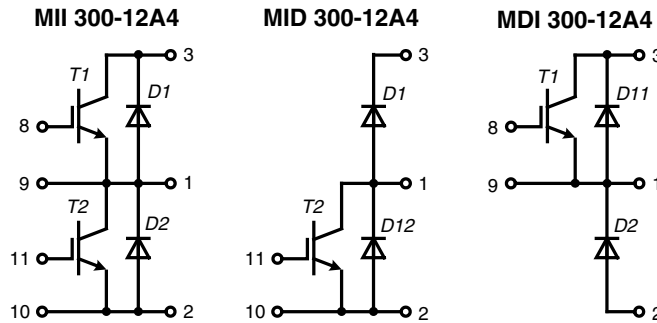


IGBT Modules

Short Circuit SOA Capability
 Square RBSOA

$I_{C25} = 330 \text{ A}$
 $V_{CES} = 1200 \text{ V}$
 $V_{CE(sat) \text{ typ.}} = 2.2 \text{ V}$



IGBTs T1 - T2		Maximum Ratings	
Symbol	Conditions		
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	1200	V
V_{GES}		± 20	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	330	A
I_{C80}	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	220	A
I_{CM}	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 3.3 \Omega; T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	400	A
V_{CEK}	RBSOA Clamped inductive load; $L = 100 \mu\text{H}$	V_{CES}	
t_{SC} (SCSOA)	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 3.3 \Omega$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}; \text{non-repetitive}$	10	μs
P_{tot}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	1380	W

Features

- NPT IGBT technology
- low switching losses
- switching frequency up to 30 kHz
- square RBSOA, no latch up
- high short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- ultra fast free wheeling diodes
- package with DCB ceramic base plate
- isolation voltage 4800 V
- UL registered E72873

Advantages

- space and weight savings
- reduced protection circuits

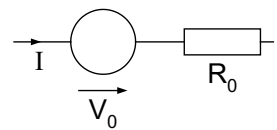
Applications

- AC and DC motor control
- AC servo and robot drives
- power supplies
- welding inverters

Symbol	Conditions	Characteristic Values				
		(T _{VJ} = 25°C, unless otherwise specified)				
		min.	typ.	max.		
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 200 \text{ A}; V_{GE} = 15 \text{ V}$		2.2	2.7	V	
$V_{GE(th)}$	$I_C = 8 \text{ mA}; V_{GE} = V_{CE}$	4.5		6.5	V	
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			13	mA	
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}; V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			± 800	nA	
$t_{d(on)}$	Inductive load $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 600 \text{ V}; I_C = 200 \text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 3.3 \Omega$		100		ns	
t_r			60		ns	
$t_{d(off)}$			600		ns	
t_f			90		ns	
E_{on}				32		mJ
E_{off}				29		mJ
C_{ies}	$V_{CE} = 25 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$		13		nF	
C_{oes}			2		nF	
C_{res}			1		nF	
R_{thJC}	(per IGBT)			0.09	K/W	
R_{thJH}	with heatsink compound		0.18		K/W	

Free wheeling diodes D1 - D2 / D11 - D12

Symbol	Conditions	Maximum Ratings			
I_{F25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	450	A		
I_{F80}	$T_C = 80^\circ\text{C}$	280	A		
Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		min.	typ.	max.	
V_F	$I_F = 300\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V};$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		2.2 1.7	2.5	V V
I_{RM} t_{rr}	$I_F = 200\text{ A}; di_F/dt = -1800\text{ A}/\mu\text{s};$ $V_R = 600\text{ V}; V_{GE} = 0\text{ V};$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		180 200		A ns
R_{thJC} R_{thJH}	(per IGBT) with heatsink compound		0.3	0.15	K/W K/W

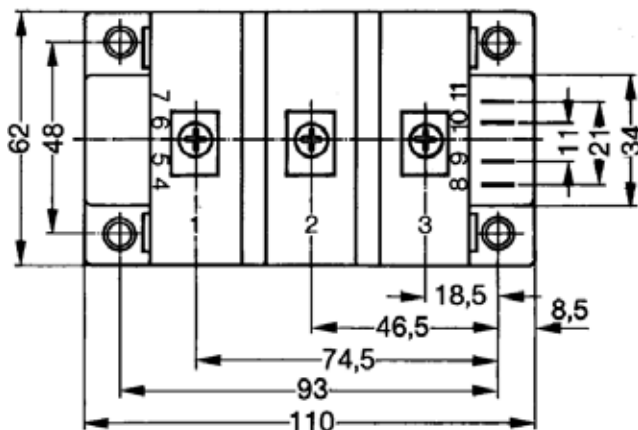
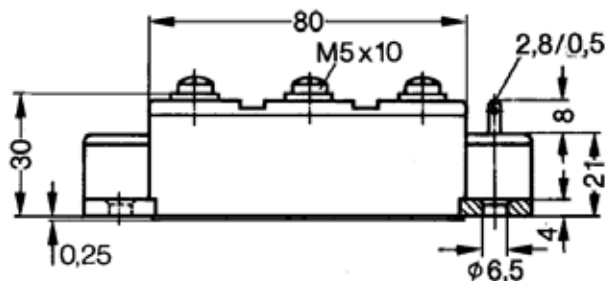
Equivalent Circuits for Simulation
Conduction


IGBT (typ. at $V_{GE} = 15\text{ V}; T_J = 125^\circ\text{C}$)
 $V_o = 1.3\text{ V}; R_o = 6.2\text{ m}\Omega$

Free wheeling diode (typ. at $T_J = 125^\circ\text{C}$)
 $V_o = 1.3\text{ V}; R_o = 2.4\text{ m}\Omega$

Module

Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
T_{VJ}	operating	-40...+150	$^\circ\text{C}$	
T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$	
V_{ISO}	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}; 50/60\text{ Hz}$	4000	V~	
M_d	Mounting torque (module, M6) (terminal, M5)	2.25 - 2.75 2.5 - 3.7	Nm Nm	
Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
d_s	Creepage distance on surface	10		mm
d_A	Strike distance in air	9.6		mm
Weight			250	g



Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

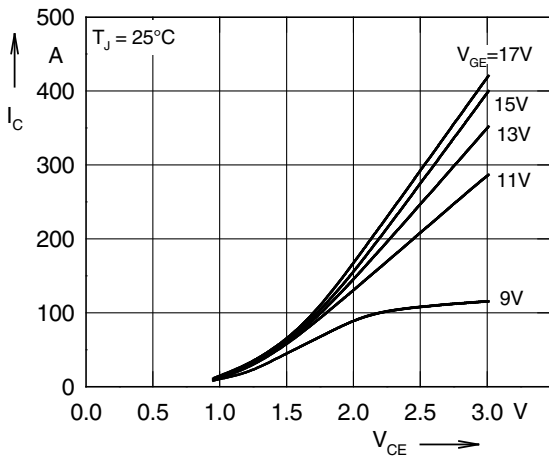


Fig. 1 Typ. output characteristics

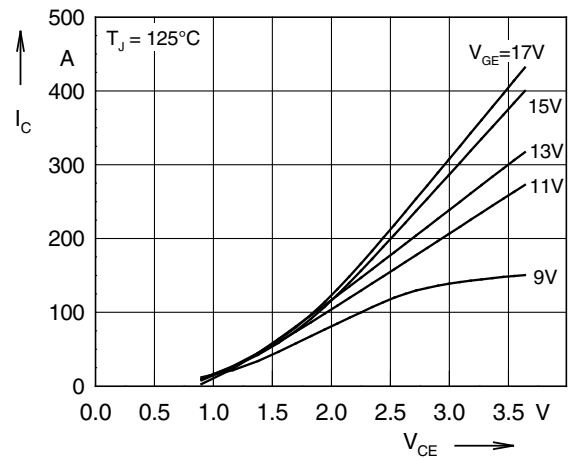


Fig. 2 Typ. output characteristics

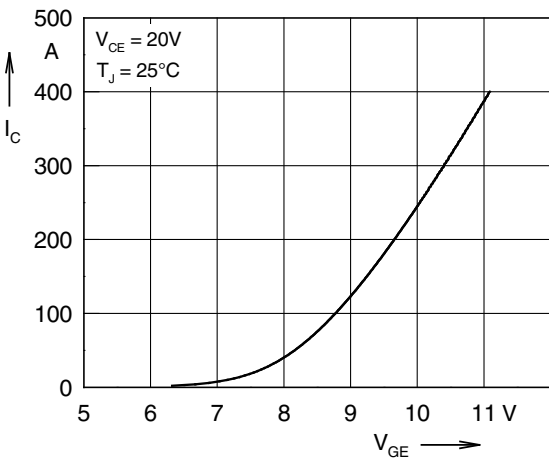


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

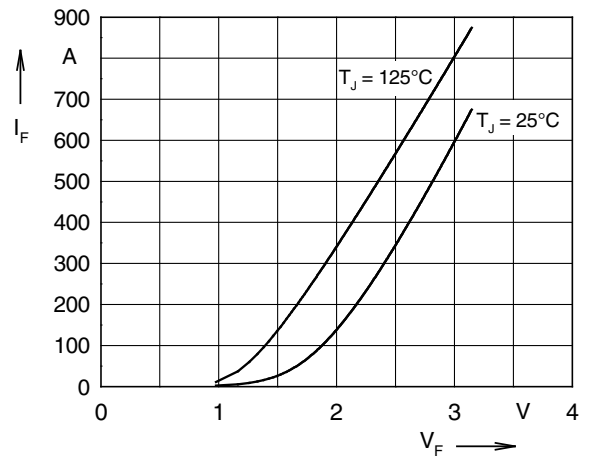


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode

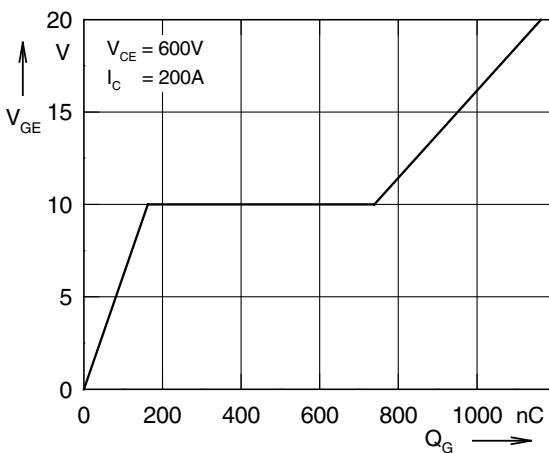


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

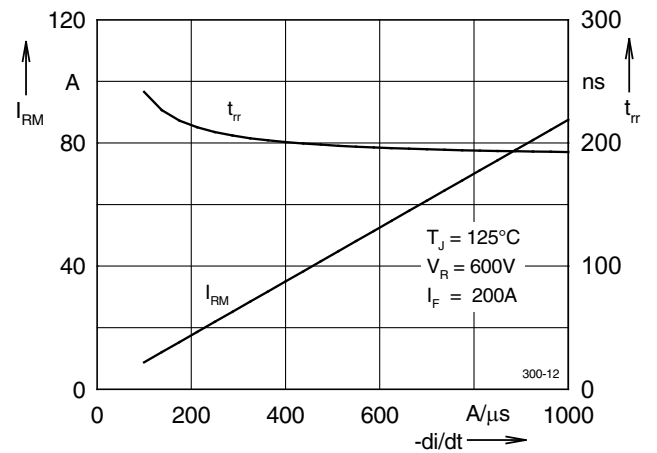


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

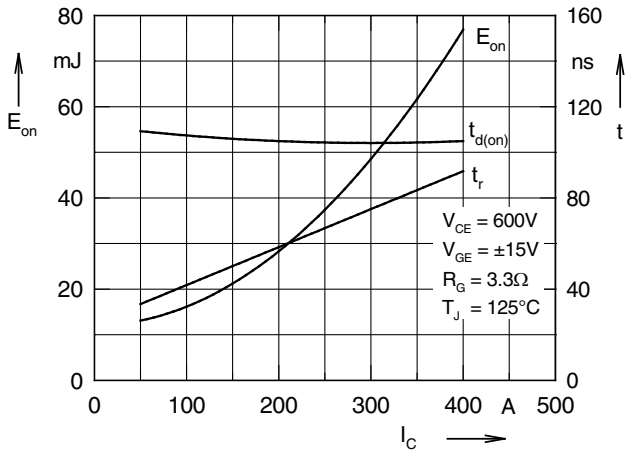


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching

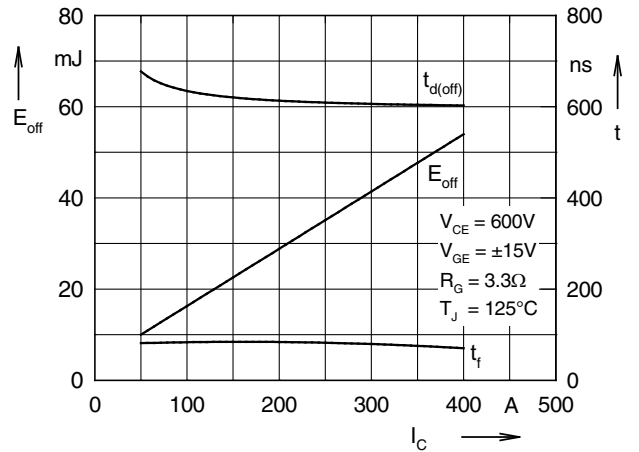


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current

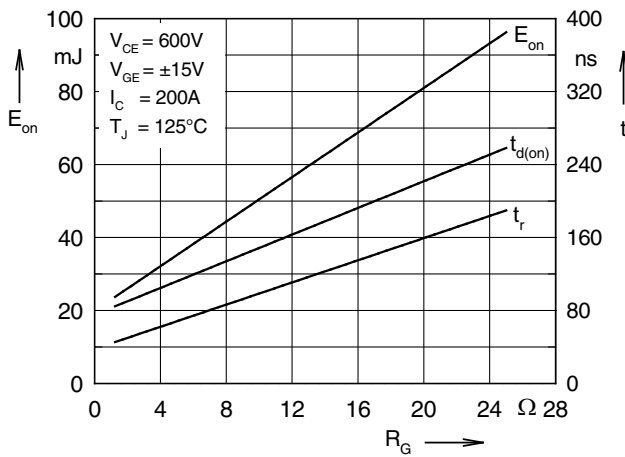


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor

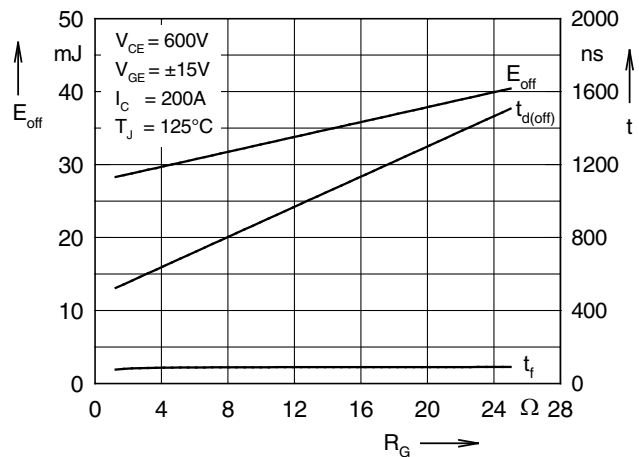


Fig.10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor

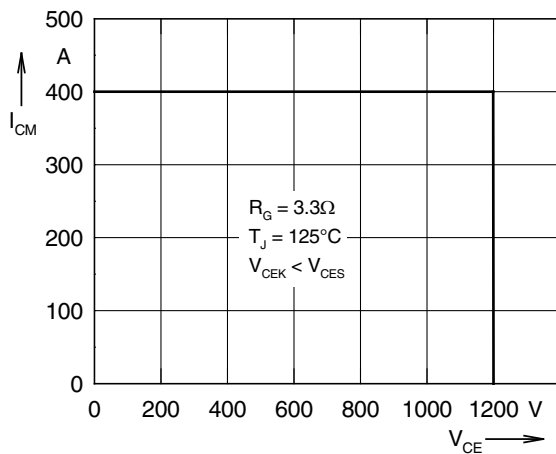


Fig. 11 Reverse biased safe operating area RBSOA

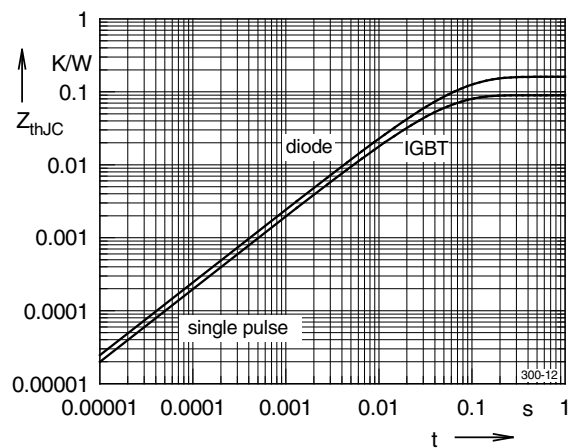


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9